

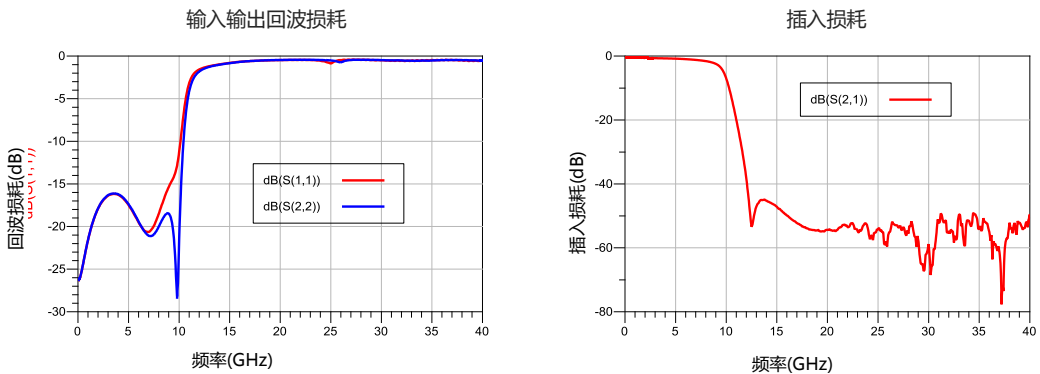
**性能特点：**

- 通带频率：DC-9GHz
- 通带损耗： $\leq 2.1\text{dB}$
- 阻带衰减： $\geq 20\text{dB}@11.7\text{GHz}$ ， $\geq 40\text{dB}@12.6\text{GHz}$
- 回波损耗： $\geq 17\text{dB}$
- 芯片尺寸： $1.0 \times 0.70\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

**产品简介：**

HH-LF0009 是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点，广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸  $1.0\text{mm} \times 0.70\text{mm} \times 0.1\text{mm}$ 。

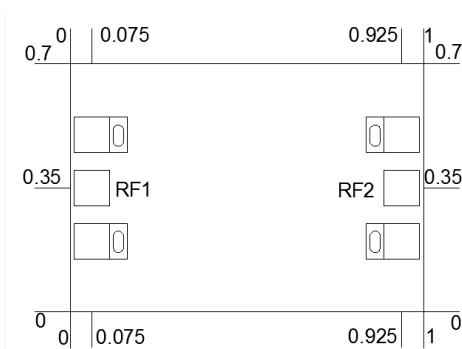
**典型曲线：** (  $T_A=25^\circ\text{C}$  )



**使用限制参数：** ( 超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。 )

最大输入功率	33 dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

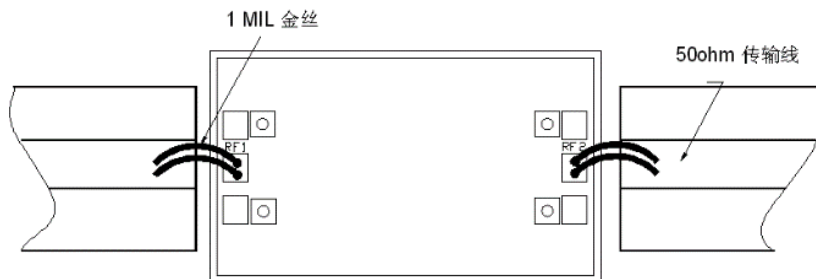
**芯片实物尺寸图：**(单位 mm)



**说明：**

1. 单位：毫米，公差： $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸： $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

### 芯片建议装配图：



### 使用说明：

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。